

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年10月22日(2009.10.22)

【公開番号】特開2007-158182(P2007-158182A)

【公開日】平成19年6月21日(2007.6.21)

【年通号数】公開・登録公報2007-023

【出願番号】特願2005-353764(P2005-353764)

【国際特許分類】

H 05 K 1/09 (2006.01)

【F I】

H 05 K	1/09	A
H 05 K	1/09	C

【手続補正書】

【提出日】平成21年9月3日(2009.9.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

樹脂フィルム上に、Cr、Ta、W、V、Y、Co及びNdのうち1種以上を合計で0.01～10.0原子%含有する銅合金層を形成してなることを特徴とするフレキシブルプリント配線板用積層体。

【請求項2】

樹脂フィルム上に、Cr、Ta、W、V、Y、Co及びNdのうち1種～3種を合計で0.01～10.0原子%含有し、かつ、Ti、Ni、Si、Mg及びAlのうち1種又は2種を合計で0.01～8.0原子%含有する銅合金層を形成してなることを特徴とするフレキシブルプリント配線板用積層体。

【請求項3】

樹脂フィルム上に、Cr、Ta、W、V、Y、Co及びNdのうち1種以上を合計で0.01～10.0原子%含有する銅合金層を形成し、該銅合金層上に銅スパッタ層及び/又は銅めっき層を形成してなることを特徴とするフレキシブルプリント配線板用積層体。

【請求項4】

樹脂フィルム上に、Cr、Ta、W、V、Y、Co及びNdのうち1種～3種を合計で0.01～10.0原子%含有し、かつ、Ti、Ni、Si、Mg及びAlのうち1種又は2種を合計で0.01～8.0原子%含有する銅合金層を形成し、該銅合金層上に銅スパッタ層及び/又は銅めっき層を形成してなることを特徴とするフレキシブルプリント配線板用積層体。

【請求項5】

請求項1、3に記載の銅合金層を形成するためのスパッタリングターゲットであって、Cr、Ta、W、V、Y、Co及びNdのうち1種以上を合計で0.01～10.0原子%含有するCu合金よりなることを特徴とするCu合金スパッタリングターゲット。

【請求項6】

請求項2、4に記載の銅合金層を形成するためのスパッタリングターゲットであって、Cr、Ta、W、V、Y、Co及びNdのうち1種～3種を合計で0.01～10.0原子%含有し、かつ、Ti、Ni、Si、Mg及びAlのうち1種又は2種を合計で0.01～8.0原子%含有するCu合金よりなることを特徴とするCu合金スパッタリングタ

ーゲット。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】フレキシブルプリント配線板用積層体及び該積層体の銅合金層の形成に用いるCu合金スパッタリングターゲット

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

本発明は、フレキシブルプリント配線板の素材であって、樹脂フィルム（ベースフィルム）上に接着剤を用いずに導体層を形成してなる2層構造タイプのフレキシブルプリント配線板用積層体及び該積層体の銅合金層の形成に用いるCu合金スパッタリングターゲットに関するものである。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0022】

請求項4の発明は、樹脂フィルム上に、Cr、Ta、W、V、Y、Co及びNdのうち1種～3種を合計で0.01～10.0原子%含有し、かつ、Ti、Ni、Si、Mg及びAlのうち1種又は2種を合計で0.01～8.0原子%含有する銅合金層を形成し、該銅合金層上に銅スパッタ層及び/又は銅めっき層を形成してなることを特徴とするフレキシブルプリント配線板用積層体である。請求項5の発明は、請求項1、3に記載の銅合金層を形成するためのスパッタリングターゲットであって、Cr、Ta、W、V、Y、Co及びNdのうち1種以上を合計で0.01～10.0原子%含有するCu合金よりなることを特徴とするCu合金スパッタリングターゲットである。請求項6の発明は、請求項2、4に記載の銅合金層を形成するためのスパッタリングターゲットであって、Cr、Ta、W、V、Y、Co及びNdのうち1種～3種を合計で0.01～10.0原子%含有し、かつ、Ti、Ni、Si、Mg及びAlのうち1種又は2種を合計で0.01～8.0原子%含有するCu合金よりなることを特徴とするCu合金スパッタリングターゲットである。